

HVXシリーズ パワー-MOSFET

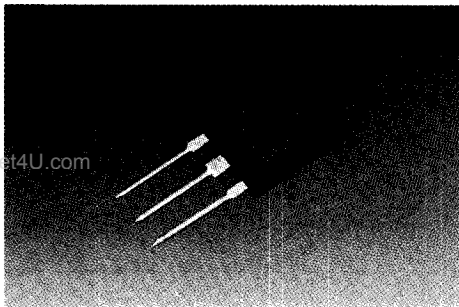
HVX SERIES POWER MOSFET

高速スイッチング
N-チャネル、エンハンスメント型

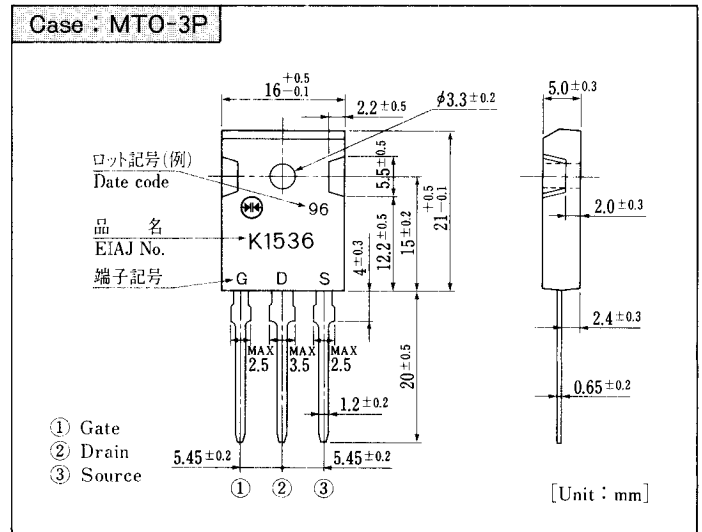
2SK1536

(F3W90)

900V 3A



外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



定格表 RATINGS

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	℃
チャネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150	℃
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage	V _{DSS}		900	V
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage	V _{GSS}		±30	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	3	A
	Peak	I _{DP}	6	
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)		I _S	3	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _c =25℃	70	W
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 5 kg·cm) (Recommended torque : 5kg·cm)	8	kg·cm

電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_c=25℃)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D =1mA, V _{GS} =0V	900			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =900V, V _{GS} =0V			250	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V			±100	nA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =1.5A, V _{DS} =10V	1	1.8		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D =1.5A, V _{GS} =10V		4	5	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =1mA, V _{DS} =10V	2	3	4	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =1.5A, V _{GS} =0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{JC}	接合部・ケース間 Between junction and case			1.79	℃/W
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		740		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			60		pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			130		pF
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =1.5A, V _{GS} =10V, R _L =100Ω		45	90	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			110	220	ns

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

